



## Транзистор КТ838А

## ЭТИКЕТКА

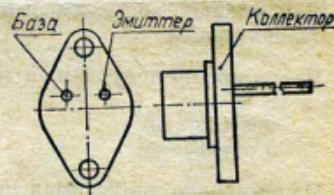
11-Р-11

Кремниевый высоковольтный меза-планарный мощный транзистор КТ838А предназначен для работы в схемах горизонтальной развертки телевизоров и видеоконтрольных устройств.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3.1, 5.1.

Корпус типа КТ-9 по ГОСТ 18472-82

Масса не более 20 г



**Основные электрические параметры при Т корп. =  $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$**

Наименование параметра ( режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначен.	Норма	
		не менее	не более
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В Ик = 4,5 В, Иб = 2 А	Икэ нас	—	5
Напряжение насыщения база-эмиттер, В Ик = 4,5 В, Иб = 2 А	Ибэ нас	—	1,5
Постоянное напряжение эмиттер-база, В Ик = 0, Иэбо = 0,01 А Ик = 0, Иэбо = 0,1 А	Иэбо	5 7	—
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА Икэк = 1500 В	Икэк	—	1
Границочное напряжение, В Л = 40 мГн, Ик = 0,1 А	Икэо гр	700	—
Время спада, мкс Иб нас = Иб зап = 1,8 А, Икк = 500 В, Ик = 4,5 А, Ибэ отр = -5 В, Тнас = Тзап = 40 мкс	Тсп	—	1,5

Наименование параметра (режим и условия измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер ( $R_{B3} \leq 10$ Ом, $t_{on} \leq 20$ мкс, $t_{off} \geq 2$ мкс, $Q \geq 4$ ), В при Ткорп. от $-45^{\circ}$ до $+95^{\circ}$ C при Ткорп. = $100^{\circ}$ C	ИкэR, и макс	1500 1100
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	Ик макс	5
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А	Ик, и макс	7,5
Максимально допустимый запирающий ток базы, А постоянный импульсный	Iб зап макс Iб зап, и макс	0,1 3,5
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт при Ткорп. $\leq 95^{\circ}$ C	Рк макс	12,5
Максимально допустимая температура перехода, °C	Тп макс	115

Содержание драгметаллов в 1000 транзисторов:

Золота — 0,7238 г

Содержание цветных металлов и их сплавов в 1000 шт.

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса, г
Медь	МОБ	2900 г

**Сведения о приемке**

Транзистор КТ838А соответствует техническим условиям аАО.336.408ТУ

Штамп ОТК

Штамп Государственной приемки

**Указания по эксплуатации**

Указания по применению и эксплуатации по ГОСТ 11630-84, ОСТ 11 336.907.0-79.  
Транзистор необходимо применять с теплоотводом.

Крепление транзистора к теплоотводу должно обеспечивать надежный тепловой контакт. На нижнее основание корпуса транзистора необходимо наносить жидкость ПМС-100 ГОСТ 13032-77 или другую теплопроводящую смазку. В случае применения изолирующей прокладки, последняя покрывается жидкостью (смазкой) с 2-х сторон.

При наике выводов температура корпуса не должна превышать  $100^{\circ}$ C.